## BEST AVAILABLE COPY

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-022033

(43) Date of publication of application: 23.01.1996

(51)Int.CI.

GO2F 1/136

GO2F 1/1333

GO2F 1/1343

G09G 3/36

(21)Application number: 06-153363

(71)Applicant: CITIZEN WATCH CO LTD

(22) Date of filing:

05.07.1994

(72)Inventor: KANEKO YASUSHI

#### (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obviate the inversion of a halftone contrast display even when a visual angle is inclined forward as the voltages impressed to respective display electrodes constituting one pixel vary, to obtain a high contrast as a nonlinear resistance element structure is Ta-Ta2O5-ITO and to obtain a specified display characteristic even if a photoetching stage fluctuates as the areas of the nonlinear resistance elements are constant.

CONSTITUTION: This liquid crystal display device has a first substrate having the nonlinear resistance elements consisting of first electrodes 2, nonlinear resistance layers and second electrodes 4 formed of indium tin oxide films, display electrodes and driving electrodes 9 and a second substrate having counter electrodes 11. The one pixel is composed of the one counter electrode 11, the plural display

electrodes 6, 8 and the nonlinear resistance elements 5, 7 connected to these display electrodes 6, 8 and is so constituted that the areas of the display electrodes are the same and that the areas of the nonlinear resistance elements 5, 7 varv.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

24.05.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3291396 [Date of registration] 22.03.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998.2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁(JP)

#### (12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

#### (11)特許出願公開番号

#### 特開平8-22033

(43)公開日 平成8年(1996)1月23日

(51) Int.Cl.6

職別記号 5 1 0 FΙ

技術表示箇所

G 0 2 F 1/136

1/1333

1/1343

G 0 9 G 3/36

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

特願平6-153363

(71)出願人 000001960

シチズン時計株式会社

(22)出願日

平成6年(1994)7月5日

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72) 発明者 金子 靖

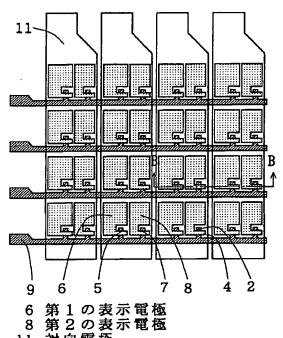
埼玉県所沢市大字下富字武野840番地 シ チズン時計株式会社技術研究所内

#### (54) 【発明の名称】 液晶表示装置

#### (57)【要約】

【構成】 第1の電極2と非線形抵抗層3と酸化インジウムスズ膜で設ける第2の電極4とからなる非線形抵抗案子と表示電極と駆動電極9を有する第1の基板1と、対向電極11を有する第2の基板10とを備え、1画素を1つの対向電極と、複数の表示電極と、表示電極へ接続する非線形抵抗素子とで構成し、かつ表示電極面積は同一で、非線形抵抗素子の面積が異なるように構成する。

【効果】 1 画素を構成する各表示電極への印加電圧が 異なるため、前方向に視角を傾けたときでも中間調表示 が反転せず、非線形抵抗索子構造として、Ta-Ta2 O6-ITOであるため高コントラストで、非線形抵抗 素子面積が一定であるためフォトエッチング工程が変動 しても、一定の表示特性が得られる。



11 対向電極

#### 【特許請求の範囲】

【簡求項1】 第1の電極と非線形抵抗層と第2の電極とからなる非線形抵抗索子と表示電極と駆動電極とを有する第1の基板と、対向電極を有する第2の基板と、第1の基板と第2の基板との間に封入する液晶とを備え、1 画案を1つの対向電極と複数の表示電極と各表示電極に接続する非線形抵抗索子とで構成し、そしてそれぞれの非線形抵抗索子の面積は同一で、かつ表示電極の面積が異なるように構成し、非線形抵抗索子と表示電極との容量比が異なることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 第1の電極と非線形抵抗層と第2の電極とからなる非線形抵抗素子と表示電極と駆動電極とを有する第1の基板と、対向電極を有する第2の基板と、第1の基板と第2の基板との間に封入する液晶とを備え、1 画素を1つの対向電極と複数の表示電極と各表示電極に接続する非線形抵抗素子とで構成し、そしてそれぞれの表示電極の面積は同一で、かつ非線形抵抗素子の面積が異なるように構成し、非線形抵抗素子と表示電極との容量比が異なることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】 第1の電極と非線形抵抗層と第2の電極 20 とからなる非線形抵抗素子と表示電極と駆動電極を有する第1の基板と、対向電極を有する第2の基板と、第1 の基板と第2の基板との間に封入する液晶とを備え、

1 画素を1つの対向電極と複数の大きさの異なる表示電極と各表示電極に接続する複数の大きさの異なる非線形抵抗素子とで構成し、そして面積の大きな表示電極には面積の小さい非線形抵抗素子を接続し、面積の小さな表示電極には面積の大きな非線形抵抗素子を接続し、非線形抵抗素子と表示電極との容量比が異なることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】 第1の基板に設ける第2の電極は、表示電極と同一材料である透明導電膜で構成することを特徴とする請求項1、請求項2、あるいは請求項3に記載の液晶表示装置。

【請求項5】 第1の基板の非線形抵抗素子の上、あるいは第1の基板の非線形抵抗素子と表示電極上とには、 絶縁膜を備えることを特徴とする請求項1、請求項2、 請求項3、あるいは請求項4に記載の液晶表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、アクティブマトリクス 液晶表示パネルに適用する液晶スイッチング案子に用い られる金属-絶縁体-金属、あるいは金属-絶縁体-透 明導館体構造(以下MIMと配載する)を有する非線形 抵抗素子をもつ液晶表示パネルの構造に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、液晶表示パネルを用いた液晶表示 装置の表示容量は、大容量化の一途をたどっている。そ して、単純マトリクス構成の表示装置にマルチプレクス 駆動を用いる表示方式は、高時分割化するに従ってコン 50 トラストの低下、あるいは応答速度の低下が生じる。したがって、200本程度の走査線をもゆ表示装置では、 充分なコントラストを得ることが難しくなる。

【0003】そこで、このような欠点を除去するために、個々の画素にスイッチング素子を設けるアクティブマトリクス方式の液晶表示パネルが採用されてきている。

【0004】このアクティブマトリクス方式の液晶表示 パネルには、スイッチング素子として、薄膜トランジス 10夕(TFT)を用いる三端子系と、非線形抵抗索子を用 いる二端子系とがある。そして、これらのなかでは構造 や製造方法が簡単な点で、二端子系が優れている。

【0005】この二端子系には、ダイオード型や、バリスタ型や、MIM型などが開発されている。このうち、MIM型はとくに構造が簡単で、そのうえ製造工程が短いという特徴を備えている。

【0006】図6は、非線形抵抗素子を用いた従来のMIM型液晶表示装置の構成を示す平面図である。さらに図7は、図6の平面図におけるA-A線での断面を示す断面図である。以下図6と図7とを交互に用いて従来技術を説明する。

【0007】第1の基板31上には、第1の電極32を 設け、この第1の電極32上に、非線形抵抗層33を設 ける。さらに第2の電極34を非線形抵抗層33上にオ ーパーラップするように設けて、非線形抵抗素子30を 構成している。この第2の電極34の一部は、表示電極 35を兼ねている。

【0008】そして第2の基板36には、表示電極35 と対向するように対向電極39を設けている。

30 【0009】第1の基板31上に設ける第1の電板32 は、図6の平面図に示すように、通常は第1の電極32 と同一材料で形成する駆動電極38と接続し、表示電極 35とは一定の間隔寸法を隔てて配置している。

【0010】表示電極35は、対向電極39と重なり合うように配置することにより、液晶表示パネルの1画素を構成する。

【0011】 さらに第1の基板31と第2の基板36とは、液晶41の分子を規則的に並べるための処理層として、それぞれ配向膜40、40を設ける。

40 【0012】 さらにそのうえスペーサー42によって、 第1の基板31と第2の基板36とを所定の間隔をもっ て対向させ、第1の基板31と第2の基板36との間に は、液晶41を封入する。

【0013】駆動電極38に走査信号を印加するときは、対向電極39にデータ信号を印加することによって、表示電極35を所望の明るさに制御することができる。

【0014】また逆に、対向電極39に走査信号を印加し、駆動電極38にデータ信号を印加しても、表示電極35を所望の明るさに制御することが可能である。

20

3

【0015】 書込み時に駆動電極38と対向電極39の間に印加する替込み電圧Vinのうち、非線形抵抗素子30に印加する電圧Vmimは、表示電極35の容量Clcを非線形抵抗素子30の容量Cmimで除した値である容量比CRを用い、Vmim=Vin×CR/(1+CR)で決定される。

【0016】非線形抵抗索子30の抵抗は、印加電圧が高いほど低くなるため、容量比CRが大きいとVmimが大きくなり、非線形抵抗索子30は低抵抗になり、液晶にデータ信号を有効に書込むことができる。

【0017】 曹込み終了後の保持時には、表示電極35と対向電極39間の液晶41に保持する電圧V1cは、C1cとCmimの容量結合により $\Delta V$ だけ電圧降下し、 $\Delta V$ =Vin/(1+CR) で示される。

【0018】したがって、容量比CRが大きいほど $\Delta V$ が小さくなる。その結果、液晶41に保持する電圧V1 c は大きくできる。その後、つぎの書込みまで、液晶41に保持する電圧V1 c は液晶容量C1 c により保持される。

[0019]

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の液晶表示パネルは、液晶41の配向状態が第1の基板31と第2の基板36の間で $80\sim100$ 度ねじれた状態にあるツイストネマティック(TN)モードである。このTNモードの液晶表示パネルは、この液晶表示パネルを前後左右に傾けて見たときの明るさが変わり、視角特性が悪い。

【0020】図8に従来例の液晶表示パネルの前後方向の表示特性を示す。横軸は表示電極35と対向電極39間への印加電圧を示し、縦軸は透過率を示す。90°ツイストのTNモードの液晶表示パネルに、上下の偏光板を90°直交する状態で設置し、ノーマリ白モードのときである。

【0021】図8のグラフの実線Lは、液晶表示パネルを正面から見たときの透過率-電圧特性を示し、実線Mは前方向に40°傾けたときの透過率-電圧特性を示し、実線Nは後方向に40°傾けたときの透過率-電圧特性を示す。

【0022】正面で、黒表示を出すためにはV1の電圧を印加すればよく、白表示を出すためにはV3の電圧を印加し、中間調の灰色表示をするためにはV2の電圧を印加する。

【0023】灰色表示と黒表示とを表示した状態で、液晶表示パネルを後方向に $40^\circ$  傾けると、黒表示は実線Lと直線V1の交点から、実線Nと直線V1の交点へ変わり明るくなる。これに対して、灰色表示は実線Lと直線V2の交点から、実線Nと直線V2への交点に変わり、かなり白くなりコントラストが低下する。

【0024】これとは反対に、液晶表示パネルを前方向 に40°傾けると、黒表示は実線Lと直線V1°の交点か 50 ら、実線Mと直線V1の交点へ変わり明るくなるが、灰色表示は実線Lと直線V2の交点から、実線Mと直線V2の交点に変わり、逆に黒くなり、黒と灰色表示の反転が生じる。このため、著しく表示品質が低下するという問題点が発生する。

【0025】この視角特性を改善する手段として、特開 平5-53150号公報に開示されている手段がある。 この公報には、1画素を複数の表示電極とその表示電極 に接続する非線形抵抗素子で構成し、しかも表示電極と 非線形抵抗素子の容量比を異なるように構成することが 記載されている。

【0026】特開平5-53150号公報で図1として 記載されている図面を、90°回転した形で転記した図 9を用いて、この公報に記載の液晶表示装置の構成を説 明する。

【0027】1 画素を1つの対向電極51と、第1の表示電極54と第2の表示電極55とで構成する。しかも、第1の表示電極54と第1の非線形抵抗素子58の面積比と、第2の表示電極55と第2の非線形抵抗素子59との面積比を変える。

【0028】したがって、第1の表示電極54と第1の 非線形抵抗素子58との容量比と、第2の表示電極55 と第2の非線形抵抗素子59の容量比が異なり、同一の データ信号で書込んでも、第1の表示電極54と第2の 表示電極55の駆動電圧が変わるようになる。

【0029】図5のグラフを使用して、液晶表示装置で 視角特性が改善される作用を説明する。図5の横軸は駆 動電極50と対向電極51間に印加する電圧を示し、縦 軸は液晶表示装置の透過率を示す。

【0030】実線Xは、容量比CR=表示電極容量C1 c/非線形抵抗素子容量Cmimの大きな第2の表示電極55のときの前方向に40°傾けた電圧-透過率曲線を示し、実線Yは、容量比の小さな第1の表示電極54 のときの前方向に40°傾けた電圧-透過率特性を示す。

【0031】容量比の小さい第1の表示電極54では、 書込み時の非線形抵抗素子への印加電圧が低くなり、非 線形抵抗素子の抵抗が充分小さくならず、書込み効率が 低下する。さらに、保持時の電圧降下量ΔVも大きくな るため、容量比の高い表示電極に比べて高電圧を印加し なくてはならないため、実線Yは実線Xよりも高電圧側 へ移動する。

【0032】 画素の明るさは、複数の表示電極の平均となる。平均の電圧-透過率曲線を破線2で示す。正面から見て黒表示の印加電圧V1と灰色表示のV2を印加するとき、実線Xでは黒灰の反転が起きているが、破線2では、黒灰反転はおきず、前方向の視角特性が改善される。

【0033】しかしながら、図5の破線2の急峻性が、 実線Xの急峻性よりも低下していることからもわかるよ

5

うに、正面の電圧-透過率曲線Lの急峻性も低下する。 このため、黒表示をするためには、図8における電圧V 1以上の電圧が必要となり、非線形抵抗索子の駆動能力 として、V1-V3よりも、さらに大きな駆動能力が必 要になる。

【0034】MIM索子の駆動能力は、索子構造や案子 構成や索子材料や製造条件により決定されるが、最も影 響が大きいのか素子材料である。

【0035】さきの特開平5-053150号公報で使用している非線形抵抗素子は、図9に示すように第1の電極52と、第1の電極52を陽極酸化して設ける非線形抵抗層と、第2の電極56と第2の電極57とで構成している。

【0036】この公報中では、詳細には記載されていないが、第2の電極56、57と表示電極54、55の材質が異なっているのは明白でる。そして、第2の電極56、57としては、クロム(Cr)などの金属膜が使用されていると推定される。

【0037】第1の電極52としてタンタル(Ta)膜を用いて、Ta-Ta2O6-Crの素子材料で形成する非線形抵抗素子は駆動能力が少ない。このため、充分大きな駆動電圧を印加することができず、表示コントラストが低下するために、視角特性が改善されても、実用化が難しい。

【0038】またさらに、特開平5-53150号公報の図1、図5、図6のいずれにおいても、面積の大きな表示電極には面積の大きな非線形抵抗素子を、面積の小さな表示電極には面積の小さな非線形抵抗素子を接続している。

【0039】したがって、表示電極と非線形抵抗素子と 30 の面積比の変化量が少なくなっており、容量比の差も少なくなり、表示電極間の駆動電圧差を大きくすることは困難であるといわざるをえない。

【0040】さらに、非常に小さな第2の非線形抵抗索子59を使用しているため、非線形抵抗索子を形成するフォトエッチング工程でのオーパーエッチングやアンダーエッチングによる面積比の変動を受ける確率が、第1の非線形抵抗索子58よりも第2の非線形抵抗素子59の方が大きい。このために、駆動電圧が基板毎に変動する。

【0041】本発明の目的は、駆動能力の大きなMIM 案子と、表示電極と非線形抵抗案子との容量比が大きく 異なる複数の表示電極を用いて、液晶表示パネルを前方 向へ傾けたときに発生する黒と灰色表示の反転を押さえ て、良好な視角特性を有し、しかもコントラストも充分 な液晶表示装置の構造を提供することである。

【0042】さらに本発明の目的は、フォトエッチング 工程でのオーパーエッチングやアンダーエッチングがあっても、複数の表示電極の駆動電圧差があまり変化せず、常に一定の表示特性が得られる液晶表示装置の構造 50 を提供することである。

[0043]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の液晶表示装置は、第1の電極と非線形抵抗層と第2の電極とからなる非線形抵抗素子と表示電極と駆動電極とを有する第1の基板と、対向電極を有する第2の基板と、第1の基板と第2の基板との間に封入する液晶とを備え、1 画素を1つの対向電極と複数の表示電極と各表示電極に接続する非線形抵抗素子とで構成し、そしてそれぞれの非線形抵抗素子の面積は同一で、かつ表示電極の面積が異なるように構成し、非線形抵抗素子と表示電極との容量比が異なることを特徴とする。

6

【0044】また本発明の液晶表示装置は、第1の電極と非線形抵抗層と第2の電極とからなる非線形抵抗素子と表示電極と駆動電極とを有する第1の基板と、対向電極を有する第2の基板と、第1の基板と第2の基板との間に封入する液晶とを備え、1 画素を1つの対向電極と複数の表示電極と各表示電極に接続する非線形抵抗素子とで構成し、そしてそれぞれの表示電極の面積は同一で、かつ非線形抵抗素子の面積が異なるように構成し、非線形抵抗素子と表示電極との容量比が異なることを特徴とする。

【0045】また本発明の液晶表示装置は、第1の電極と非線形抵抗層と第2の電極とからなる非線形抵抗素子と表示電極と駆動電極を有する第1の基板と、対向電極を有する第2の基板と、第1の基板と第2の基板との間に封入する液晶とを備え、1画素を1つの対向電極と複数の大きさの異なる表示電極と各表示電極に接続する複数の大きさの異なる非線形抵抗素子とで構成し、そして面積の大きな表示電極には面積の小さい非線形抵抗素子を接続し、面積の小さな表示電極には面積の大きな非線形抵抗素子を接続し、非線形抵抗素子と表示電極との容量比が異なることを特徴とする。

【0046】さらにまた本発明の液晶表示装置は、第1 の基板に形成する第2の電極は、表示電極と同一材料で ある透明導電膜で構成ることを特徴とする。

【0047】またさらに本発明の液晶表示装置は、第1の基板の非線形抵抗素子の上、あるいは第1の基板の非線形抵抗素子と表示電極上には、絶縁薄膜を備えることを特徴とする。

[0048]

40

【作用】本発明の液晶表示装置の画案構造は、1 画案を非線形抵抗案子容量と表示電極容量との容量比が異なる複数の画素に分割した構造となり、容量比が異なっている。このため、同一のデータ信号で書込んでも、それぞれの表示電極への印加電圧が変わるようになり、電圧一透過率特性がなだらかになり、視角特性を改善することができる。

【0049】さらに、1画素を構成する複数の表示電極と、表示電極に接続する非線形抵抗索子とは、非線形抵

抗索子の面積を一定にして、そして表示電極の面積のみ を異なるようにする。このことで、従来例よりも容量比 の変化率を大きくすることができ、視角特性の改善効果 が大きくすることができる。

【0050】さらに、フォトエッチング工程におけるオ ーパーエッチングやアンダーエッチングが生じても、非 線形抵抗素子の面積が同じである。このために、容量比 の変動率が少なく、常に一定の表示特性が得られる。

【0051】さらに、第2の電極材料に表示電極と同一 材料である透明導電膜である酸化インジウムスズ膜を用 いて、Ta-Ta2 Os -ITOの案子構造にする。こ のことで、MIM素子の駆動能力が向上し、コントラス トを低下させずに視角特性を改善することができる。

[0052]

【実施例】以下に本発明の実施例における液晶表示装置 の構成を、図面を使用して説明する。

【0053】図1は、本発明の第1の実施例における液 晶表示装置の構造を示す平面図である。図2は、図1の 平面図のB-B線における断面を示す断面図である。以 下、図1と図2とを交互に用いて本発明の第1の実施例 20 の液晶表示装置の構成を説明する。

【0054】第1の基板1上には、タンタル(Ta)膜 からなる第1の電極2を設ける。さらにこの第1の電極 2上には、第1の電極2を陽極酸化処理して設ける酸化 タンタル (Ta2 O6) 膜からなる非線形抵抗層 3を設 ける。

【0055】さらに非線形抵抗層3上に、透明導電膜と して酸化インジウムスズ (IT〇) 膜からなる第2の電 極4を設ける。

【0056】この第1の質極2と非線形抵抗層3と第2 の電極4とによって、MIM構造の第1の非線形抵抗素 子5と第2の非線形素子7とを構成している。

【0057】なお図1の平面図に示すように、第2の重 極4の一部領域は、第1の表示電極6と第2の表示電極 8を兼ねている。また、第1の電極2はタンタル膜から なる駆動電極9に接続している。

【0058】第1の表示電極6と第2の表示電極8との 面積は異なるように構成している。本発明の実施例にお いては、第1の表示電極6の面積は、第2の表示電極8 よりおよそ30%大きくなるように構成している。

【0059】さらに第2の基板10には、第1の表示電 極6と第2の表示電極8と対向するように、酸化インジ ウムスズ膜からなる対向電極11を設ける。

【0060】第1の表示電極6と第2の表示電極8と は、それぞれ対向電極11と重なり合うように配置する ことにより、第1の表示電極6と第2の表示電極8との 2つで液晶表示装置の1画案となり、所定の表示を行

【0061】さらに第1の基板1と第2の基板10と

て、それぞれ配向膜12、12を設ける。さらにそのう えスペーサー14によって、第1の基板1と第2の基板 10とを所定の間隔をもって対向させ、そしてこの第1 の基板1と第2の基板10との間には、液晶13を封入 している。

【0062】つぎに以上説明した本発明の第1の実施例 における液晶表示装置による、動作について説明する。

【0063】本発明の第1の実施例では、4型の白黒液 晶表示装置を用いる。表示部の対角10cmで横640 画素×縦240画素、画素ピッチは横125μm×縦2 40 μmである。

【0064】第1の表示電極6は横65μm×縦200 μmで、第2の表示電極8は横45μm×縦200μ m、第1の非線形抵抗素子5と第2の非線形抵抗素子7 の面積は $3 \mu m \times 3 \mu m$ 、液晶ギャップは $4 \mu m$ であ

【0065】非線形抵抗層3は、約0.07μmと薄 く、誘電率は25~30と液晶の誘電率3~5と比較し て5~10倍も大きい。このため、第1の表示電板6と 第1の非線形抵抗素子5の容量比は約4で、第2の表示 電極8と第2の非線形抵抗素子7の容量比は約3とな

【0066】したがって、書込時に第1の非線形抵抗素 子5に印加される電圧Vmim1は4/5Vinとな り、第2の非線形抵抗索子7に印加される電圧Vmlm 2は3/4Vinとなり、Vmim2=Vmim1×1 5/16となる。

【0067】駆動電極9と対向電極11間の印加電圧V inとして、およそ10V印加したとき、第1の表示電 30 極6と第2の表示電極8との間に約0.5 Vの電圧差が 発生する。

【0068】図5において、実線Xは容量比4の第1の 表示電極6における前方向に40。傾けた電圧-透過率 特性を示し、実線Yは容量比3の第2の表示電極8にお ける前方向に40°傾けた電圧-透過率特性を示す。

【0069】画素の明るさは、2つの表示電極の平均と なり、平均の電圧-透過率曲線を破線2で示す。正面か ら見て黒表示の印加電圧V1と灰色表示のV2を印加す るとき、実線Xでは黒灰の反転が起きているが、本発明 の特性を示す破線とでは、黒灰反転は発生せず、前方向 の視角特性が改善されている。

【0070】第1の非線形抵抗素子5と第2の非線形抵 抗索子7として、Ta-Ta2 Os-ITOの材料を用 いているために、MIM素子の駆動能力が高く、充分な コントラスト特性も得ることができる。

【0071】本発明の第1の実施例では、さらに、第1 の非線形抵抗索子5と第2の非線形抵抗索子7の面積を 一定にして、そして第1の表示電極6と第2の表示電極 8との表示電極の面積のみを異なるように構成する。こ は、液晶13の分子を規則的に並べるための処理層とし 50 のことで、従来例よりも容量比の変化率を大きくでき、

視角特性の改善効果が大きくすることができる。

【0072】さらに、フォトエッチング工程におけるオーパーエッチングやアンダーエッチングが生じ、非線形抵抗素子面積が変化しても、第1の非線形抵抗素子5と第2の非線形抵抗素子7の面積は同じである。このために、第1の表示電極6と第2の表示電極8の電圧差の変化は少なく、常に一定の表示特性が得られる。

【0073】つぎに、本発明における第1の実施例の液晶表示装置の製造方法について、図1と図2を用いて簡単に説明する。

【0074】第1の基板1には、アルカリ金属の含有率の少ないガラスがよく、本発明の第1の実施例では、日本電気硝子製の商品名OA2を用い、厚さ1.1mmのものを使用する。

【0075】つぎに、第1の基板1に第1の電極2と駆動電極9の材料として、全面に厚さ0.1~0.3 $\mu$ mのタンタル膜をスパッタリング法や真空蒸着法により形成する。その後、エッチングガスとしてSF。とへリウムと酸素の混合ガスを用いたドライエッチングによりタンタル薄膜をパターンニングし、第1の電極2と駆動電 20極9を形成する。駆動電極9の配線線幅は20 $\mu$ mで、第1の電極2の非線形素子部線幅3 $\mu$ mとする。

【0076】つぎに、クエン酸やほう酸アンモニウムなどの陽極酸化液を満たした陽極酸化槽に第1の基板1を浸漬し、 $30V\sim50V$ の直流電圧を印加して、陽極酸化処理により厚さ $0.05\sim0.1\mu$ mの酸化タンタル( $Ta_2O_5$ )膜からなる非線形抵抗層3を形成する。

【0077】さらに、第2の電極4の材料と表示電極との材料として、全面に透明導電膜である酸化インジウムスズ膜をスパッタリング法や真空蒸着法により厚さ0.1から0.3 $\mu$ mに設け、フォトエッチング処理により、第2の電極4と第1の表示電極6と第2の表示電極8を設ける。本発明の第1の実施例では、塩化第2鉄と塩酸の混合溶液を用いて酸化インジウムスズ膜のエッチングを行い、第2の電極4の線幅は3 $\mu$ mとする。

【0078】つぎに、第2の基板 10の製造方法について説明する。第2の基板 10も、第1の基板 1と同一のガラス基板を用い、対向電極 11の材料として、厚さ0.1から0.4  $\mu$ mの酸化インジウムスズ膜をスパッタリング法や真空蒸着法により設け、フォトエッチング 40により対向電板 11を設ける。

【0079】第1の基板1と第2の基板10の両基板に配向膜12を印刷法で形成後、ラビング処理を行い、スペーサー14を挟んで、エポキシ系接着材で両基板を所定の間隔で張り合わせ、液晶13を注入する。

【0080】そして第1の基板1と第2の基板10との外側に偏光板を偏光軸が90°に交差するように張り付けて、ノーマリー白モードのMIM方式アクティブマトリクス液晶表示装置となる。

【0081】本発明の第1の実施例では、液晶13は、

10

フッソ系で $\Delta$ n=0.13の材料を用い、セルギャップは $4\mu$ mにする。

【0082】本発明の実施例における4型のMIM方式の白黒液晶表示装置は、正面でも充分なコントラスト特性をもち、さらに前後方向に傾けたときの視角特性が改善され、中間階調の反転のない良好な表示品質が得られている。またさらに、左右方向に傾けたときの視角特性は、数値上では従来と変わらないが、目視時は上下視野角の成分が含まれるので、従来より広く見える。

10 【0083】本発明の第1の実施例においては、好ましくは第1の基板1の第1の非線形抵抗索子5と第2の非線形抵抗素子7の上、あるいは第1の基板1の第1の非線形抵抗素子5と第2の非線形抵抗素子7と第1の表示電極6と第2の表示電極8の上に、スパッタリング法を用いて厚さ0.1~0.5μmの2酸化シリコンや酸化タンタルの絶縁膜を設ける。この絶縁膜は、第1の非線形抵抗素子5および第2の非線形抵抗素子7と液晶13の相互作用を取り除く。このことで、焼き付き現象が低減し、さらに高品質の表示画像を提供することができ20。

【0084】本発明の第1の実施例では、1画素を2組の非線形抵抗素子と表示電極で構成したが、3組以上の非線形抵抗素子と表示電極で構成することも可能である。

【0085】つぎに、本発明の液晶表示装置における第2の実施例を図3と図4とを用いて説明する。図4は、本発明の第2の実施例の構成を示す断面図で、図3の平面図のC-C線における断面を示している。以下、図3と図4とを交互に用いて本発明の第2の実施例における液晶表示装置の構成を説明する。

【0086】第1の基板1上には、タンタル(Ta)膜からなる第1の電極2を設け、さらにこの第1の電極2上には、第1の電極2を陽極酸化処理して設ける酸化タンタル( $Ta_2O_5$ )膜からなる非線形抵抗層3を設ける。

【0087】さらに非線形抵抗層3上に透明導電膜として、酸化インジウムスズ(ITO)膜からなる第2の電極4を設ける。

【0088】この第1の電極2と非線形抵抗層3と第2 の電極4とによって、MIM構造の第1の非線形抵抗素 子5と第2の非線形素子7とを設ける構成としている。

【0089】なお図3の平面図に示すように、第2の電極4の一部領域は、第1の表示電極6と第2の表示電極8を兼ねている。また、第1の電極2はタンタル膜からなる駆動電極9に接続している。

【0090】本発明の第2の実施例では第1の表示電極6の面積と、第2の表示電極8の面積は同じである。しかしながら、第1の非線形抵抗索子5を構成する第1の電極2の線幅は3μm、第2の非線形抵抗索子7を構成50する第1の電極2の線幅は4μmと第1の電極2の線幅

寸法を異なるように構成する。

【0091】さらに第2の基板10には、クロム膜を図3で右下がり斜線で示す形状にパターンニングして形成するプラックマトリクス15を設ける。さらに、表示部上にカラーフィルター16、17を設ける。

【0092】カラーフィルター16、17の上に、アクリル系樹脂からなる絶縁膜18を設ける。さらに第1の表示電極6と第2の表示電極8とに対向するように、酸化インジウムスズ膜からなる対向電極11を設ける。

【0093】第1の表示電極6と第2の表示電極8とは、対向電極11と重なり合うように配置する。このことにより、第1の表示電極6と第2の表示電極8との両方で液晶表示パネルの1画素となり、所定の表示を行う。

【0094】さらに第1の基板1と第2の基板10とは、液晶13の分子を規則的に並べるための処理層として、それぞれ配向膜12、12を設ける。さらにそのうえスペーサー14により、第1の基板1と第2の基板10とを所定の間隔をもって対向させる。そして、第1の基板1と第2の基板10との間には、液晶13を封入している。

【0095】つぎに、本発明の第2の実施例における液晶表示装置による動作について説明する。

【0096】本発明の第2の実施例では、4型のカラー 液晶表示装置を用いる。表示部の対角10cmで横64 0画素×縦240画素、画素ピッチ寸法は、横125μ m×縦240μmである。

【0097】第1の表示電極6と第2の表示電極8は、横 $55\mu$ m×縦 $200\mu$ mと同一であるが、第1の非線 形抵抗素子5の第1の電極2の線幅は $3\mu$ m、第2の電 30極4の線幅は $3\mu$ mで、面積は $9\mu$ m²、第2の非線形抵抗素子7の第1の電極2の線幅は $4\mu$ m、第2の電極 4の線幅は $3\mu$ mで、面積は $12\mu$ m²となる。液晶ギャップは $4\mu$ mである。

【0098】非線形抵抗層3は、約 $0.07\mu$ mと薄く、誘電率は $25\sim30$ と液晶の誘電率 $3\sim5$ と比較して $5\sim10$ 倍も大きい。

【0099】このため、第1の表示電極6と第1の非線 形抵抗索子5の容量比は約4で、第2の表示電極8と第 2の非線形抵抗索子7の容量比は約3となる。

【0101】駆助電極9と対向電極11間の印加電圧Vinとして、およそ10V印加したとき、第1の表示電極6と第2の表示電極8との間に約0.5Vの電圧差が発生する。

【0102】図5において、実線Xは容量比4の第1の 50 どの陽極酸化液を満たした陽極酸化槽に第1の基板1を

表示電極6における前方向に40°傾けた電圧-透過率 特性を示し、実線Yは容量比3の第2の表示電極8にお ける前方向に40°傾けた電圧-透過率特性を示す。

12

【0103】 國素の明るさは、複数の表示電極の平均となり、平均の電圧 - 透過率曲線を破線2で示す。正面から見て黒表示の印加電圧V1と灰色表示のV2を印加するとき、実線Xでは黒灰の反転が起きているが、本発明の特性を示す破線2では、黒灰反転はおきず、前方向の視角特性が改善している。

10 【0104】第1の非線形抵抗索子5と第2の非線形抵抗索子7として、Ta-Ta2 O5-ITOの材料を用いているために、MIM索子の駆動能力が高く、充分なコントラスト特性も得ることができる。

【0105】さらに、第1の表示電極6と第2の表示電極8の面積を一定にして、第1の非線形抵抗素子7と第2の非線形抵抗素子7の面積のみを異なるように構成している。このことで、従来例よりも容量比の変化率を大きくでき、視角特性の改善効果が大きくすることができる。

20 【0106】さらに、表示電極形成工程におけるオーパーエッチングやアンダーエッチングが生じ、表示電極面積が変化しても、第1の表示電極6と第2の表示電極8の面積が同じである。このために、第1の表示電極6と第2の表示電極8の電圧差の変化は少なく、常に一定の表示特性が得られる。

【0107】非線形抵抗素子形成工程におけるオーパーエッチングやアンダーエッチングが生じ、非線形抵抗面積が変化しても、従来例よりも第1の非線形抵抗素子5と第2の非線形抵抗素子7の面積差が少ない。このため、第1の表示電極6と第2の表示電極8の電圧差の変化は少なくなり、一定の表示特性が得られる。

【0108】つぎに、本発明における第2の実施例の液 晶表示装置の製造方法について、図3と図4を用いて簡 単に説明する。

【0109】第1の基板1には、アルカリ金属の含有率の少ないガラスがよく、本発明の第2の実施例では、日本電気硝子製の商品名OA2を用い、厚さ1.1mmのものを使用する。

【0110】つぎに、第1の基板1に、第1の電極2と駆動電極9の材料として、全面に厚さ0.1~0.3 $\mu$ mのタンタル膜をスパッタリング法や真空蒸着法により設ける。その後、エッチングガスとしてSF。とへリウムと酸素の混合ガスを用いたドライエッチングにより、タンタル膜をパターンニングして、第1の電極2と駆動電極9とを設ける。ここで駆動電極9の配線線幅は20 $\mu$ mで、第1の非線形抵抗素子5の第1の電極2の線幅は3 $\mu$ mで、第2の非線形抵抗素子7の第1の電極2の線幅は4 $\mu$ mである。

【0111】 つぎに、クエン酸やほう酸アンモニウムなどの関極酸化液を満たした関極酸化糖に第1の基板1を

浸渍し、30V~50Vの直流電圧を印加して、陽極酸 化処理により厚さ 0. 05~0. 1 μmの酸化タンタル (Ta2 O6) 膜からなる非線形抵抗層3を設ける。

【0112】さらに、第2の電極4の材料と表示電極の 材料として、全面に透明導電膜である酸化インジウムス ズ膜をスパッタリング法や真空蒸着法により厚さ0.1 から 0. 3 μ m に 設ける。 そして、 フォトエッチング処 理によって、第2の電極4と第1の表示電極6と第2の 表示電極8を設ける。本発明の実施例では、塩化第2鉄 2の電極4の線幅は3μmとする。

【0113】つぎに、第2の基板6の製造方法について 説明する。第2の基板10も、第1の基板1と同一のガ ラス基板を用い、その全面に厚さ0.1~0.2μmの クロム膜をスパッタリング法や真空蒸着法で形成する。 その後、硝酸セリウムアンモニウムと過塩素酸の混合溶 液を用いてクロム膜をフォトエッチングして、ブラック マトリクス15とする。

【0114】その後、全面に回転塗布法を用いて、ゼラ チンやカゼインなどの感光性有機材料を形成する。そし て、乾燥処理後、フォトエッチングを行い、第2の基板 10を染色槽に含浸して染色し、固着槽に含浸して固着 することにより、厚さ1μmの緑のカラーフィルター1 6を設ける。この工程を3回繰り返し、冑のカラーフィ ルター17と赤のカラーフィルター(図示せず)とを設 ける。

【0115】カラーフィルター16,17上に、絶縁膜 18の材料として、回転塗布法を用いて、アクリル系の 有機材料を形成後、温度150~200°Cの熱処理を 行って、有機材料を硬化させて、厚さ2~5 µmの絶縁 30 膜18を設ける。

【0116】つぎに、対向電極11の材料として、厚さ  $0.2 \sim 0.4 \mu$ mの酸化インジウムスズ膜を低温スパ ッタリング法により設け、フォトエッチングにより対向 電極11を設ける。

【0117】第1の基板1と第2の基板10との両基板 に配向膜12を印刷法で形成後、ラピング処理を行い、 スペーサー14を挟んで、エポキシ系接着材で両基板を 所定の間隔で張り合わせ、液晶13を注入する。

【0118】両基板の外側に偏光板を偏光軸が90°に 40 交差するように張り付けて、ノーマリー白モードのM I M方式アクティブマトリクス液晶表示装置となる。

【0119】本発明の実施例では、液晶13は、フッソ 系で $\Delta n = 0$ . 13の材料を用い、セルギャップは $4\mu$ mにする。

【0120】本発明の第2の実施例の4型のMIM方式 カラー液晶表示装置は、正面でも充分なコントラスト特 性をもち、さらに、前後方向に傾けたときの視角特性を 改善することができ、中間階調の反転のない良好な表示 品質が得られる。また、左右方向に傾けたときの視角特 50

14 性は、数値上では従来と変わらないが、目視時は上下視 野角の成分が含まれるので、従来より広く見える。

【0121】本発明の第2の実施例では、好ましくは第 1の基板1の第1の非線形抵抗素子5と第2の非線形抵 抗索子7の上、あるいは第1の基板1の第1の非線形抵 抗索子5と第2の非線形抵抗索子7と第1の表示電極6 と第2の表示電極8の上に、スパッタリング法を用いて 厚さ0.1から0.5μmの2酸化シリコンや酸化タン タルの絶縁膜を設ける。この絶縁膜は、第1の非線形抵 と塩酸の混合溶液を用いてエッチングを行う。なお、第 10 抗索子5と第2の非線形抵抗索子7と液晶13の相互作 用を取り除く役割をもつ。このことで、焼き付き現象が 低減し、さらに髙品質の表示画像を提供することができ

> 【0122】本発明の第2の実施例では、1画素を2組 の非線形抵抗素子と表示電極で構成したが、3組以上の 非線形抵抗案子と表示電極で構成することも可能であ

【0123】本発明の第2の実施例では、第1の非線形 抵抗素子5と第2の非線形抵抗素子7で、第2の電極4 の線幅は3μmと同一にして、第1の電極2の線幅を3  $\mu$ mと $4\mu$ mとに変化させたが、第1の電極2の線幅寸 法は3μmと同一にして、第2の電極4の線幅寸法を3 μmと4μmに変化させても、まったく同一の効果が得 られる。

【0124】また、第1の非線形抵抗素子5と第2の非 線形抵抗素子7で、第1の電極2の線幅と第2の電極4 の線幅との両方を変化させることも可能である。 第1の 電極2と第2の電極4との両電極の線幅を変えることに より、第1の非線形抵抗素子5と第2の非線形抵抗素子 7の面積を大きく変化させることが可能となる。

【0125】また、第1の表示電極6と第2の表示電極 8の面積を変え、しかも第1の非線形抵抗素子5と第2 の非線形抵抗素子7との面積を変えることも可能であ る。このとき、第1の表示電極6の面積を第2の表示電 極8より大きくし、第1の非線形抵抗素子5の面積は第 2の非線形抵抗素子7より小さくする。

【0126】本発明の液晶表示装置は従来例よりも、容 **量比を大きく変えることができるようになり、第1の表 示電極6と第2の表示電極8との電圧差を大きくするこ** とができるようになる。

【0127】さらに、従来例と同一の容量比差であれ ば、第1の表示電極6と第2の表示電極8との面積差、 および第1の非線形抵抗索子5と第2の非線形抵抗索子 7との面積差を小さくできる。このため、フォトエッチ ング工程におけるオーバーエッチングやアンダーエッチ ングが生じても、第1の表示電極6と第2の表示電極8 の電圧差の変動は少なく、一定の表示特性を得られる。 [0128]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明の 液晶表示装置の構成を用いることにより、充分な正面の

コントラストもちながら、かつ前後方向の視角特性が改善し、中間調表示の反転も起きにくく、しかも高コントラスト広視角特性のMIM方式の液晶表示装置を提供することができる。

【0129】さらに、フォトエッチング工程でのオーバーエッチングやアンダーエッチングがあっても、複数の表示電極の駆動電圧差があまり変化せず、常に一定の表示特性が得られ、安定した表示特性の液晶表示装置を提供できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例における液晶表示装置を示す平面図である。

【図2】本発明の第1の実施例における液晶表示装置を 示す断面図である。

【図3】本発明の第2の実施例における液晶表示装置を 示す平面図である。

【図4】本発明の第2の実施例における液晶表示装置を 示す断面図である。

【図5】液晶表示装置を前方向に40°傾けときの印加電圧と透過率との関係を示すグラフである。

【図6】従来例における液晶表示装置を示す平面図であ

る。

【図7】従来例における液晶表示装置を示す断面図である。

16

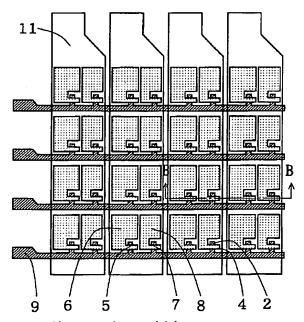
【図8】液晶表示装置の前後方向の視角特性を説明する ための印加電圧と透過率との関係を示すグラフである。

【図9】従来例における液晶表示装置を示す平面図である。

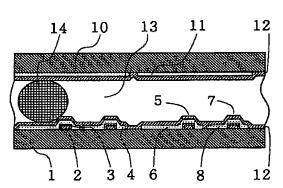
#### 【符号の説明】

- 1 第1の基板
- 10 2 第1の電極
  - 3 非線形抵抗層
  - 4 第2の電極
  - 5 第1の非線形抵抗素子
  - 6 第1の表示電極
  - 7 第2の非線形抵抗素子
  - 8 第2の表示電極
  - 9 駆動電極
  - 10 第2の基板
  - 11 対向電極
- 20 12 配向膜
  - 13 液晶

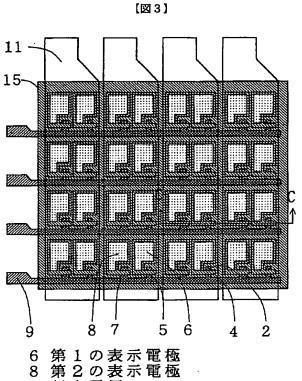
[図1]



6 第1の表示電極 8 第2の表示電極 11 対向電極 【図2】



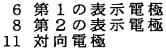
- 5 第1の非線形抵抗素子
- 6 第1の表示電極
- 7 第2の非線形抵抗素子
- 8 第2の表示電極
- 11 対向電極

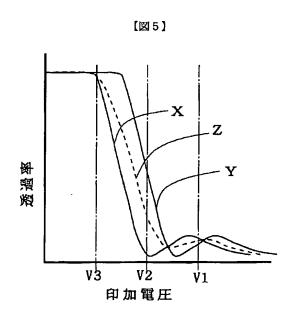


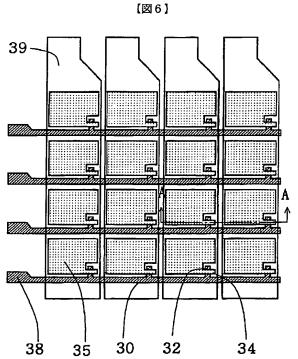
2 3 4 8 6 . 12 5 第1の非線形抵抗素子 6 第1の表示電極 7 第2の非線形抵抗素子 8 第2の表示電極 11 対向電極

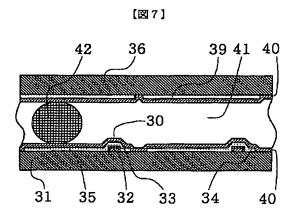
【図4】

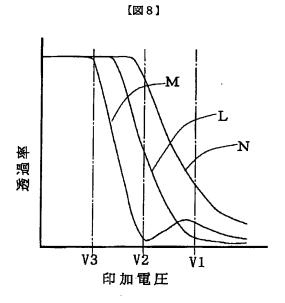
10 15 16 17 18 1113 12

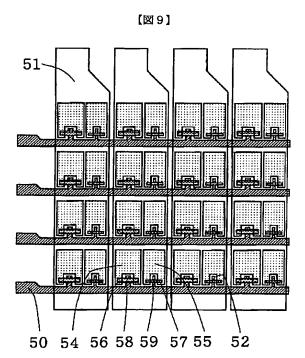












# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потикр.

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.